

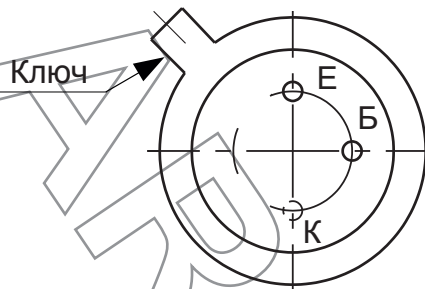
ДП КВАЗАР-ІС

ЕТИКЕТКА

Транзистори:
2Т312А,
2Т312Б,
2Т312В.

Транзистори 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В - кремнієві епітаксійно-планарні структури n-p-n універсальні. Випускаються в металоскляному корпусі КТ-1-9 (ТО-18). Застосовуються в перемикаючих пристроях, підсилювачах і генераторах радіо-електронної апаратури загального призначення.

Схема розташування виводів



Маса транзистора не більше 0,6 г.

ОСНОВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ (25 ± 10) °С

Назва параметру, одиниця вимірювання (режим вимірювання)	Сим- вол	Норма					
		2Т312А		2Т312Б		2Т312В	
		не менше	не більше	не менше	не більше	не менше	не більше
Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі зі спільним емітером (Uкб=2В, Iе=20мА, f=50–1000Гц, Q=10–100)	h_{21E}	10	100	25	100	50	250
Гранична напруга, В (Iе=7,5мА, Uке=30В)	UкЕ0гр	30	-	30	-	30	-
Зворотний струм колектора, мкА (Uкб=30В)	IкБ0	-	1	-	1	-	1
Зворотний струм емітера, мкА (Uеб=4В)	IеБ0	-	10	-	10	-	10
Напруга насичення колектор-емітер, В (Iк=20мА, Iб=2мА)	UкЕнас	-	0,5	-	0,5	-	0,35
Напруга насичення база-емітер, В (Iк=20мА, Iб=2мА)	UБЕнас	-	1,1	-	1,1	-	1,1
Модуль коефіцієнту передачі струму на високій частоті (Uкб=10В, Iе=5мА, f=20МГц)	$ h_{21E} $	4	-	6	-	6	-
Стала часу кола зворотного зв'язку, нс (Uкб=10В, Iе=5мА, f=5МГц)	tк	-	500	-	500	-	500
Час розсмоктування, нс (Iк=10мА, Iб1=2мА, Iб2=14мА)	tр	-	100	-	100	-	130

Транзистори 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В відповідають технічним умовам ЖК3.365.143 ТУ.